

Analysis of deep level centers in GaAs pin-diode structures

Korolkov, Oleg; Toompuu, Jana; Rang, Toomas Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2013 / [4 p.] : ill

Characterization of deep level traps in semiconductor structures using numerical experiments

Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina Materials characterization VII 2015 / p. 253-261 : ill

Characterization of the temperature dependent behavior of snappy phenomenon by the switching-off of GaAs power diode structures

Koel, Ants; Rang, Toomas; Rang, Galina Heat transfer XIII : simulation and experiments in heat and mass transfer 2014 / p. 439-449 : ill

Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostruktuuridel pöhinevate terahertsikiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine

Reeder, Reeno 2014 https://www.ester.ee/record=b3084247*est

Investigation of deep level centers in i- and n-layers of GaAs pin-diodes

Toompuu, Jana; Korolkov, Oleg; Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia 2014 / p. 25-28 : ill

Method of samples preparation intended for research of deep centers in i-, n-, and p-layers of GaAs p⁺-pin-n⁺ structures and result of analysis

Toompuu, Jana; Sleptšuk, Natalja; Korolkov, Oleg; Rang, Toomas BEC 2016 : 2016 15th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 15th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 3-5, 2016, Tallinn, Estonia 2016 / p. 35-38 : ill http://www.ester.ee/record=b2150914*est

Spectral properties of incoherent terahertz torch based on parabolic Ga(As,Bi)/AlGaAs quantum wells

Karaliunas, Mindaugas; Pagalys, Justas; Jakštas, Vytautas; Norkus, Ričardas; Urbanowicz, Andrzej; Devenson, Jan; Devenson, Renata; Udal, Andres; Valušis, Gintaras Terahertz Emitters, Receivers, and Applications X : SPIE Optical Engineering + Applications, 11-15 August 2019, San Diego, California, United States : proceedings SPIE digital library 2019 <https://doi.org/10.1117/12.2528428> [Conference proceeding at Scopus](#) [Article at Scopus](#) [Article at WOS](#)

Влияние дефектов эпитаксиального слоя на напряжение пробоя высоковольтных арсенид-галлиевых структур

Aškinazi, G.; Zolotarevskaja, O.; Meiler, Boriss Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1978 / с. 64-66 : илл https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Коэффициентное ударное ионизации носителей заряда в <100> арсениде галлия

Rang, Toomas; Puusepp, Märt Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1987 / с. 98-100 https://www.ester.ee/record=b2160501*est

Межфазное взаимодействие и ориентационные соотношения в системе никкель - арсенид галлия

Meiler, Boriss Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1988 / с. 3-12

Межфазное взаимодействие на контакте Ni-Si и Ni-GaAs

Meiler, Boriss Поверхность : физика, химия, механика 1985 / с. 62-67 : илл https://www.ester.ee/record=b2149829*est

Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов

Aškinazi, German; Velmre, Enn; Logussov, A.; Timofeev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Рост и морфология толстых слоев арсенида галлия, выращенных жидкофазной эпитаксией

Meiler, Boriss; Zolotarevski, L.; Paat, Aadu; Orenštein, I. Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 24-26 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP

Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Формирование морфологии и структуры толстых автоэпитаксиальных слоев арсенида галлия при росте из раствора-расплава

Zolotarevski, L.; **Meiler, Boriss**; Orenštein, I.; **Paat, Aadu** Технология быстродействующих силовых полупроводниковых приборов : сборник статей 1989 / с. 192-197 : илл https://www.ester.ee/record=b1267766*est

Численное моделирование неізотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах

Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах

Velmre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал. Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численный анализ неізотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах

Aškinazi, German; **Velmre, Enn**; Kivi, U.; Timofejev, V.; **Freidin, Boris**; Šumilin, V. Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est